



第3章 分立元件基本电路

- 3.1 共发射极放大电路
- 3.2 共集电极放大电路
- 3.3 共源极放大电路
- 3.4 分立元件组成的基本门电路





3.1 共发射极放大电路



- 3.1.1 电路组成
- 3.1.2 静态分析
- 3.1.3 动态分析
- 3.1.4 静态工作点的稳定
- 3.1.5 频率特性

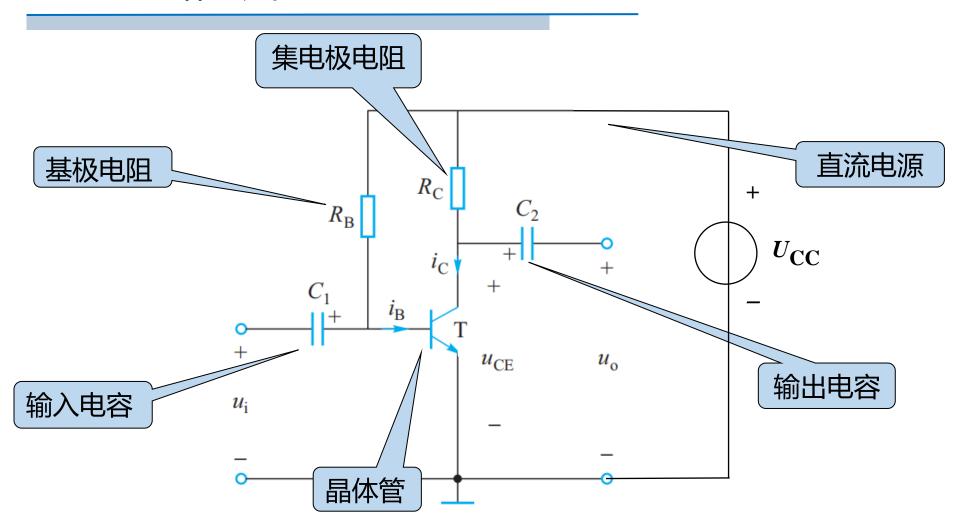








3.1.1 电路组成









3.1.1 电路组成



各元件的作用

- 晶体管: 电流放大作用, 发射结正偏, 集电结反偏;
- 直流电源 U_{CC} : 提供放大所需的能量;
- 偏置电阻 R_R : 调节 R_R , 可调节基极电流;
- 集电极负载电阻 R_c : 将集电极电流的变化转换成电压的变化送到输出端;
- 耦合电容 C_1 , C_2 : 隔直, 不适用于低频电路。







3.1.2 静态分析



所谓静态是指当放大器没有输入信号 $(u_i = 0)$ 时,电路中各处的电压电流都是直流恒定值,亦称为直流工作状态。

静态分析目的: 1)确定三极管工作状态

2) 确定三极管静态工作点的合理性

静态分析内容:在直流电源作用下,确定三极管

1) 基极电流*I_B*;

2) 集电极电流 I_C ;

3) 集电极与发射极之间的电压值 U_{CE} 。

静态分析方法: 1) 图解法;

2) 估算法。



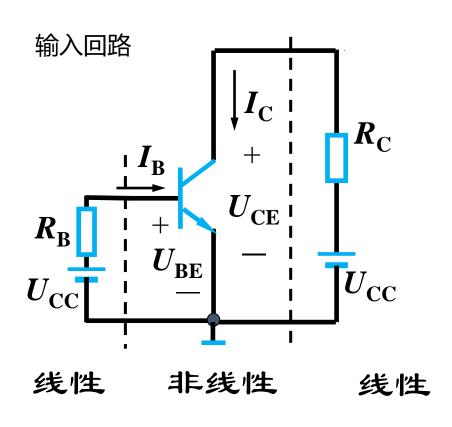




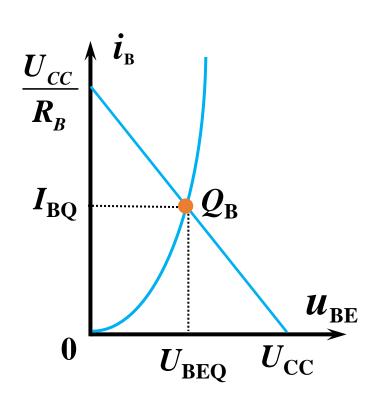




1) 图解法



$$U_{\mathrm{BE}} = U_{\mathrm{CC}} - R_{\mathrm{B}}I_{\mathrm{B}}$$



$$i_{\mathrm{B}} = f(u_{\mathrm{BE}})$$



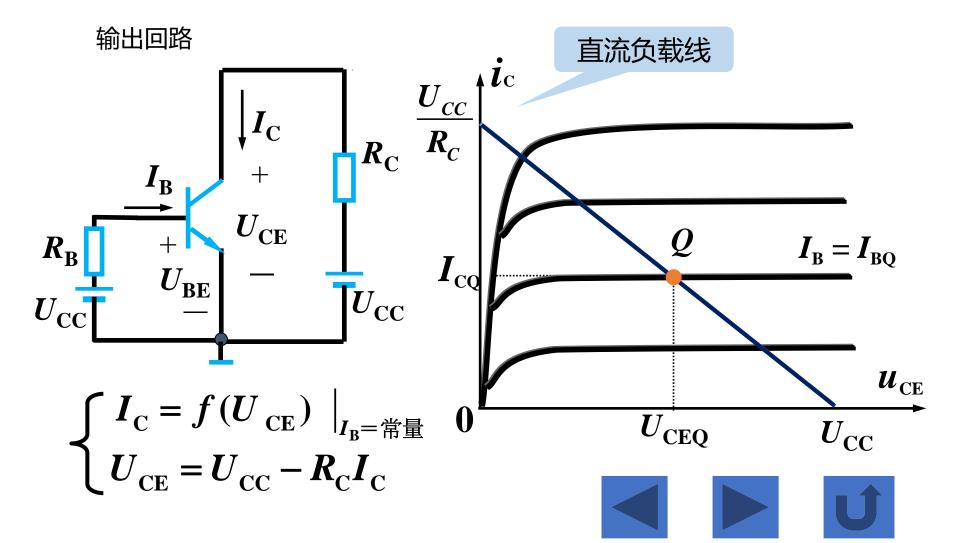






3.1.2 静态分析

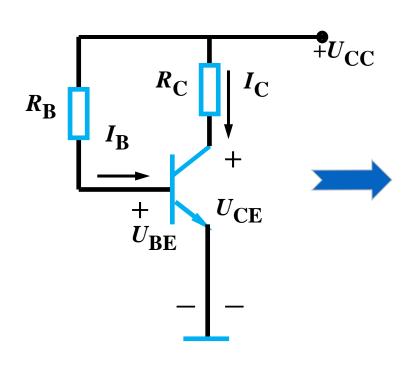
1) 图解法



3.1.2 静态分析



2) 估算法



直流通路

$$\begin{cases}
U_{CC} = R_B I_B + U_{BE} \\
U_{CC} = U_{CE} + R_C I_C
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} \\
I_C = \beta I_B \\
U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C
\end{cases}$$









所谓动态是指放大电路有信号输入时,电路中各处的电压 电流都处于变动工作状态。

动态分析内容: 输入信号变化时, 电路中各种变化量的变动情况和相互关系。

- 1) 电压放大倍数 A_U ;
- 2) 输入电阻 r_i;
- 3) 输出电阻 r_o 。

动态分析方法: 1) 图解法;

2) 微变等效电路分析方法。





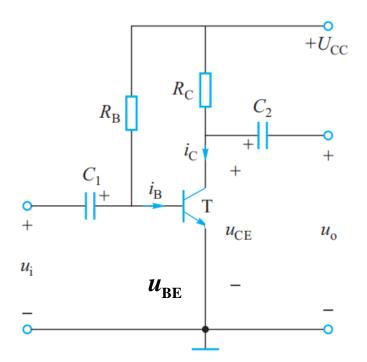


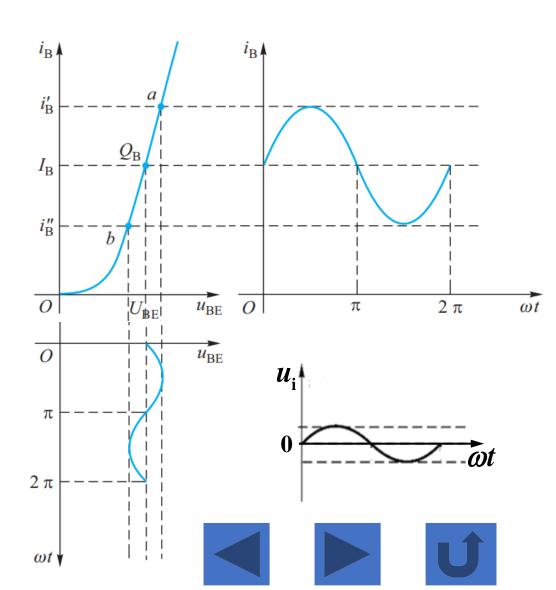


1) 图解法

输入电路

$$u_{\mathrm{BE}} = U_{\mathrm{BE}} + u_{\mathrm{i}}$$
 $i_{\mathrm{B}} = I_{\mathrm{B}} + i_{\mathrm{b}}$





ZHEJIANG UNIVERSITY

3.1.3 动态分析

1) 图解法

输出电路

$$i_C = \beta i_B = \beta I_B + \beta i_b$$
$$= I_C + i_c$$

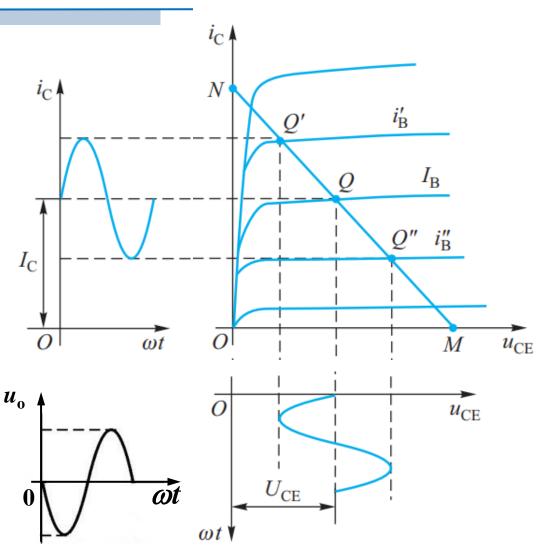
$$u_{CE} = U_{CC} - R_C i_C$$

$$= (U_{CC} - R_C I_C) - R_C i_C$$

$$= U_{CE} + u_{ce}$$

经电容隔直后:

$$u_O = u_{CE} - C_{CE}$$
$$= u_{ce}$$







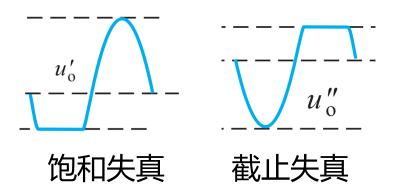


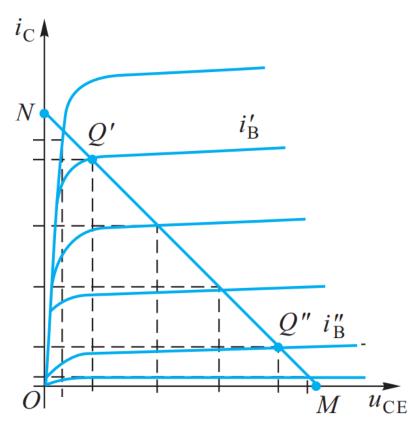


工作点与波形失真

Q点过高 饱和失真

Q点过低 截止失真









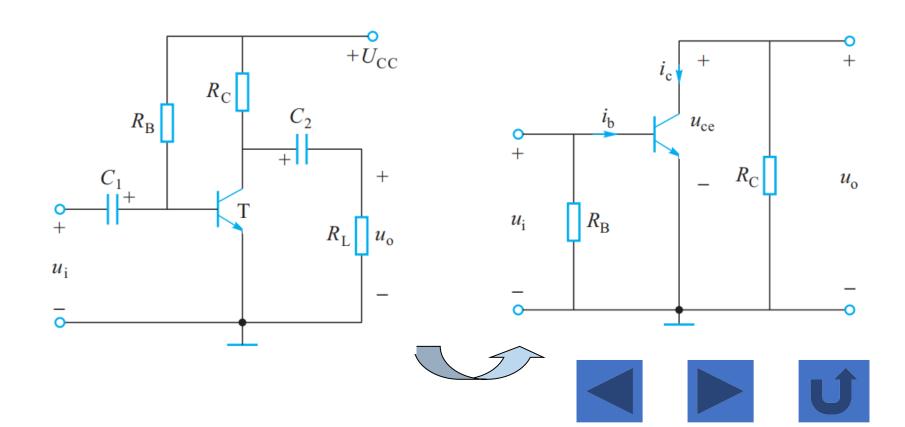




2) 微变等效电路分析法

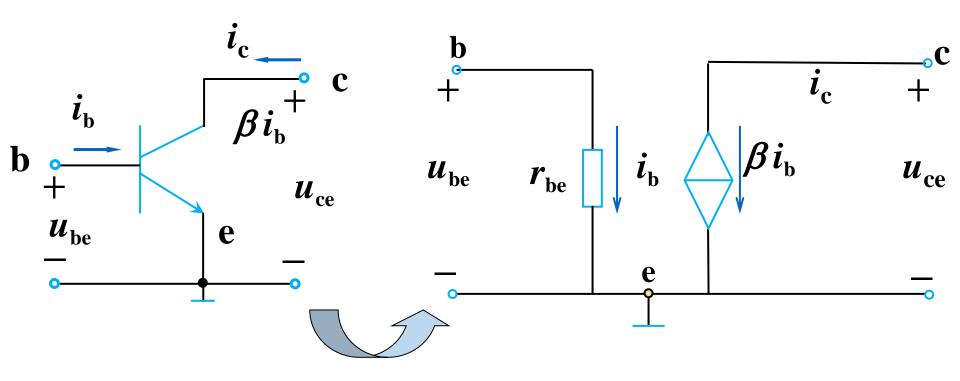
交流通路

交流通路: 将电路中的电容和直流电源短路。





晶体管的小信号模型



微变等效电路:将晶体管用小信号模型来代替。

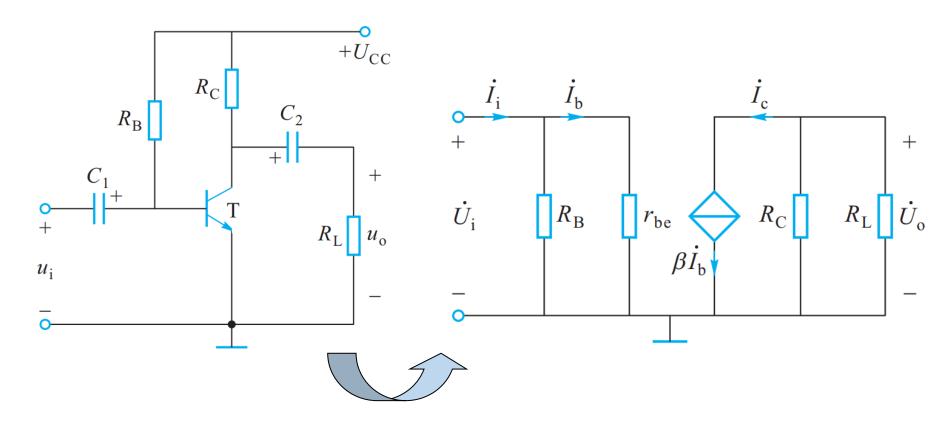








微变等效电路







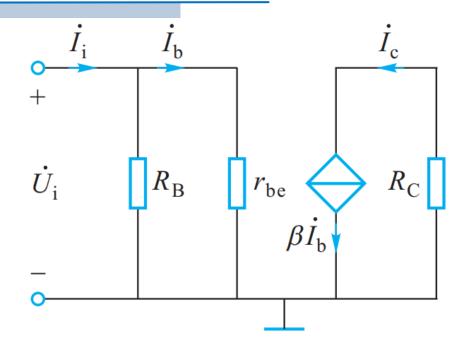




(1) 电压放大倍数

不带负载时

$$\dot{U}_{\mathrm{i}} = r_{\mathrm{be}} \dot{I}_{\mathrm{b}}$$
 $\dot{U}_{\mathrm{o}} = -\beta R_{\mathrm{C}} \dot{I}_{\mathrm{b}}$
 $A_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = -\beta \frac{R_{C}}{r_{be}}$



上式说明,选择适当的参数,可使信号得到放大。

A_u 为负值,说明输出信号与输入信号反相,即共射极放大电路具有倒相作用。

带负载时
$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_C / / R_L)}{r_{be} \dot{I}_b} = -\beta \frac{(R_C / / R_L)}{r_{be}}$$

可见带负载使放大倍数下降。



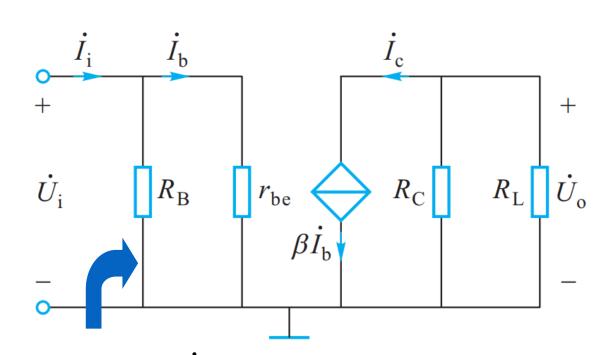






(2) 输入电阻

对信号源而言,放 大电路相当于它的负 载,负载电阻即为放 大电路的输入电阻。



放大电路的输入电阻:

$$r_i = \frac{U_i}{\dot{I}_i}$$

根据以上的微变等效电路: $r_i = R_B / r_{be}$



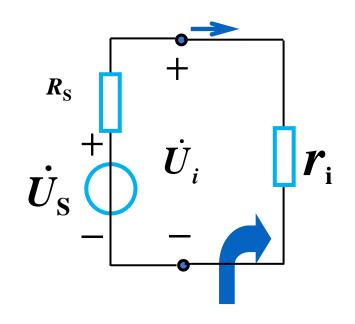






如右图所示,把一个内阻为 R_S ,源电压为 U_S 的信号源加到放大电路的输入端,由于 r_i 的存在,实际的 U_i 为:

$$\dot{\boldsymbol{U}}_{i} = \frac{\boldsymbol{r}_{i}}{\boldsymbol{R}_{S} + \boldsymbol{r}_{i}} \dot{\boldsymbol{U}}_{S}$$



ri是衡量放大电路对输入电压衰减程度的重要指标。

或者说是衡量放大电路接收输入信号能力的重要指标。





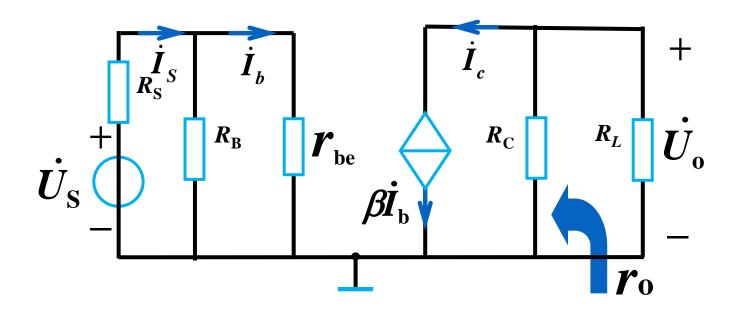


ZHEJIANG UNIVERSITY

3.1.3 动态分析

(3) 输出电阻

对负载而言,放大电路相当于一个具有内阻的信号源,信号源的内阻就是放大电路的输出电阻。



$$r_o = \frac{U}{\dot{I}} = R_c$$



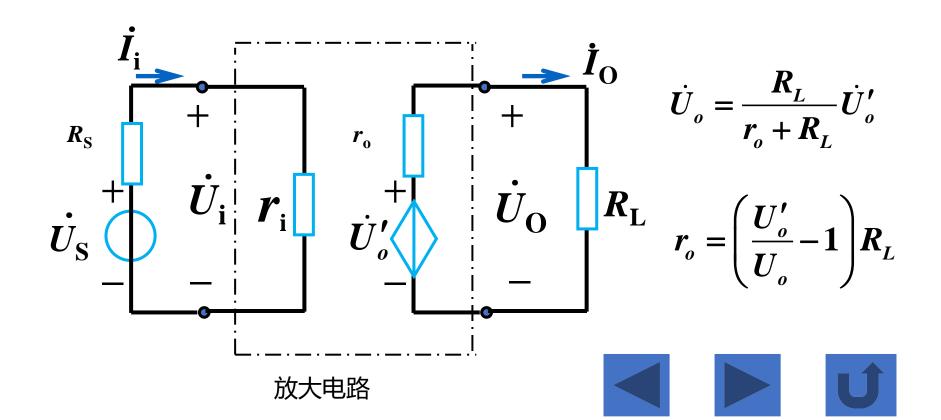






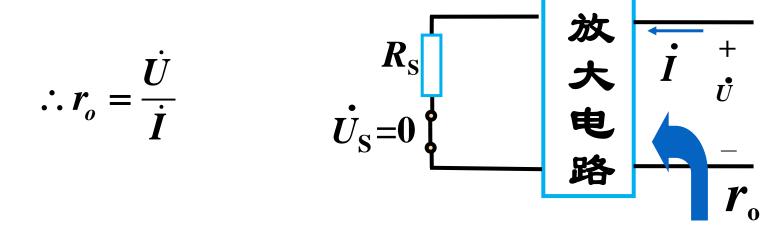
输出电阻求取——1) 实验法 适用于内部结构未知情况

分别测放大器空载电压 \dot{U}'_o 及已知 R_L 的负载电压 \dot{U}_o





输出电阻求取——2)外施电压法 适用于内部结构已知情况



可用外加电压法求 r_0

对于前面所述的共发射极放大电路

$$\therefore r_o = \frac{U}{\dot{I}} = R_c$$







例题



[例题3.1.1] 共射极放大电路如图,设 u_i 为正弦信号

已知电路参数, $U_{BE}=0.7$ V。求:

- (1) 不接负载时的放大倍数
- (2) 接负载 R_L 时的放大倍数
- (3) 放大电路的 r_i 与 r_o

[解] 静态分析

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{470 \times 10^3} = 0.024 \text{mA}$$

$$I_E = (1 + \beta)I_B = 81 \times 0.024 = 1.94 \text{mA}$$

$$I_C = 1.92 \text{mA}$$

$$U_{CE} = 6.24 \mathrm{V}$$

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 200 + 81 \times \frac{26}{1.94} = 1.286 \text{k}\Omega$$







例 题



(1) 不接负载 R_L 时的电压放大倍数

$$A_{uo} = -\beta \frac{R_C}{r_{be}} = -80 \times \frac{3 \times 10^3}{1.286 \times 10^3} = -186.6$$

(2) 接负载 R_L 时的放大倍数

$$A_u = -\beta \frac{R_L'}{r_{he}} = -80 \times \frac{1.89 \times 10^3}{1.286 \times 10^3} = -117.6$$

其中
$$R'_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} = \frac{3 \times 5.1}{3 + 5.1} = 1.89$$
kΩ

(3) 放大电路的输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o

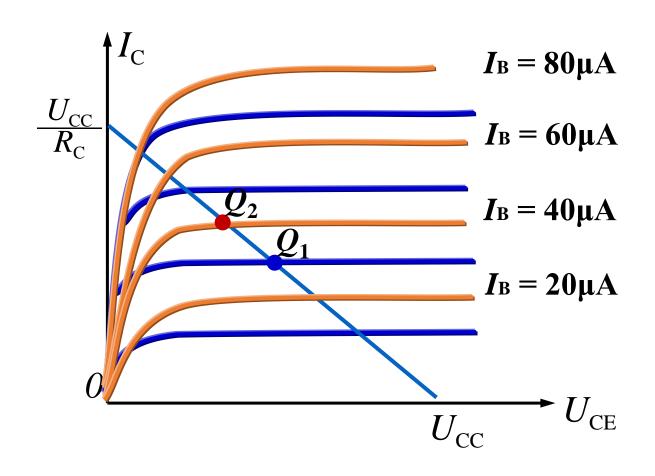
$$r_i = \frac{R_B r_{be}}{R_B + r_{be}} = \frac{470 \times 1.286}{470 + 1.286} = 1.28 \text{k}\Omega$$











温度升高时,静态工作点将沿直流负载线上移。

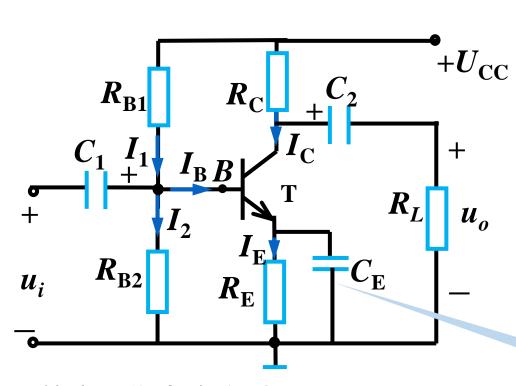








静态工作点稳定的放大电路



静态工作点稳定过程:

$$^{\bullet}_{+U_{\text{CC}}} U_{B} \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC}$$

$$I_E = \frac{U_E}{R_E} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E}$$

硅管:

$$I_1 = (5 \sim 10)I_E$$
 $U_B = 3 \sim 5V$

锗管:

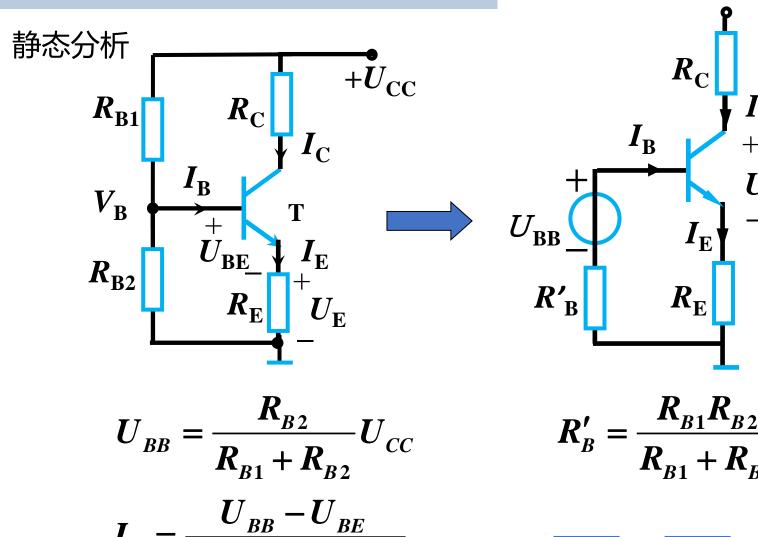
$$I_1 = (10 \sim 20)I_E$$
 $U_B = 1 \sim 3V$

C_E :旁路电容









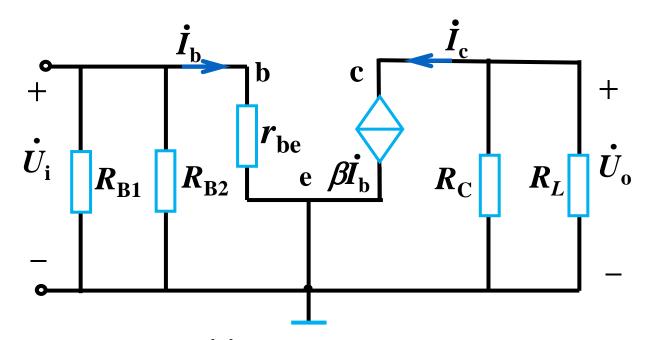






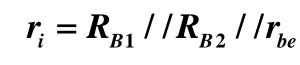


动态分析



$$A_{u} = -\beta \frac{R_{C} / R_{L}}{r_{be}}$$

$$r_o = R_C$$







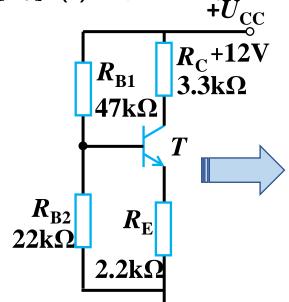


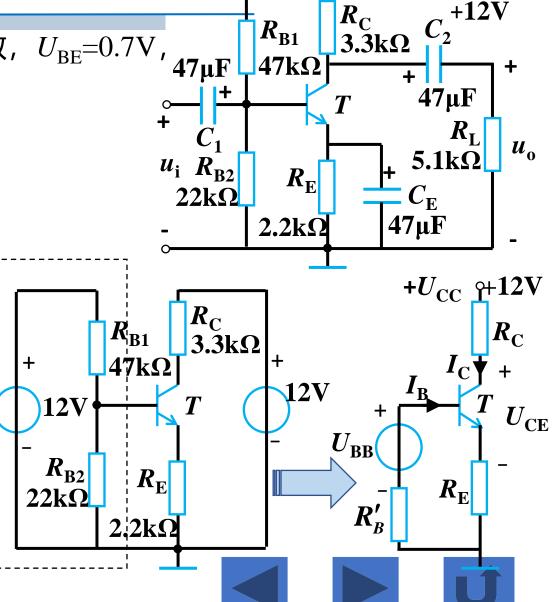
例 题

[例题3.1.2] 已知电路参数, U_{BE} =0.7V, **47μF** β=80。求:

- (1) 电路的静态工作点
- (2) 电压放大倍数
- (3) 电路的 r_i 和 r_o

[解] (1) 求静态工作点 +U_{cc}





= 4.83V



$$U_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC} = \frac{22 \times 10^3}{(47 + 22) \times 10^3} \times 12 = 3.83 \text{V}$$
 $R'_B = \frac{R_{B1}R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{47 \times 22}{47 + 22} = 14.99 \text{k}\Omega$

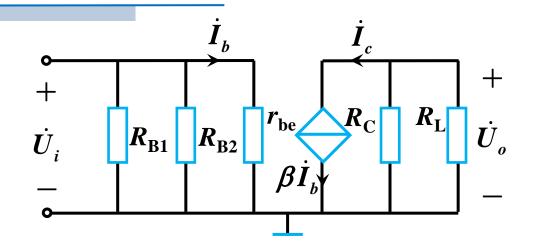
拉 $I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R'_B + (1 + \beta)R_E} = \frac{3.83 - 0.7}{(14.99 + 81 \times 2.2) \times 10^3} = 0.0162 \text{mA}$
 $I_C = \beta I_B = 80 \times 0.0162 = 1.30 \text{mA}$
 $I_E = (1 + \beta)I_B = 81 \times 0.0162 = 1.31 \text{mA}$
 $U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C - R_E I_E$
 $= 12 - 3.3 \times 10^3 \times 1.3 \times 10^{-3} - 2.2 \times 10^3 \times 1.31 \times 10^{-3}$

例 题



(2) 电压放大倍数

由于旁路电容 C_E 的作用, R_E 被交流短路,晶体管的E极直接接地



等效负载电阻
$$R'_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} = \frac{3.3 \times 5.1}{3.3 + 5.1} = 2k\Omega$$

电压放大倍数
$$A_u = -\beta \frac{R_L'}{r_{be}} = -80 \times \frac{2}{1.81} = -88.4$$

(3) 电路的
$$r_i$$
和 r_o $r_i = R_{B1} / /R_{B2} / /r_{be} = 1.61kΩ$

$$r_o = R_C = 3.3 \text{k}\Omega$$







例 题

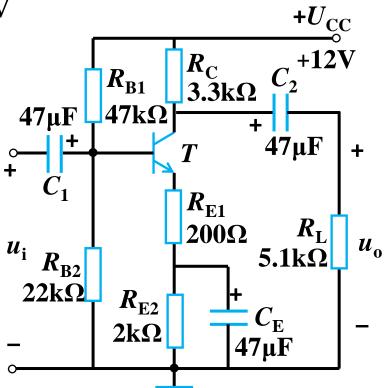


[例题3.1.3]

电路如右图所示, β =80, U_{BE} =0.7V

试计算:

- (1) 电压放大倍数
- (2) 输入电阻
- (3) 输出电阻













静态工作点与例题3.1.2相同

$$I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R'_B + (1 + \beta)R_E} = \frac{3.83 - 0.7}{(14.99 + 81 \times 2.2) \times 10^3} = 0.0162 \text{(mA)}$$

$$I_C = \beta I_B = 80 \times 0.0162 = 1.30 \text{(mA)}$$

$$I_E = (1 + \beta)I_B = 81 \times 0.0162 = 1.31 \text{ (mA)}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - R_C I_C - R_E I_E = 4.83 \text{ (V)}$$

晶体管输入电阻

$$r_{be} = 200 + (1 + 80) \frac{26}{1.31} = 1.81 \text{ (k}\Omega)$$







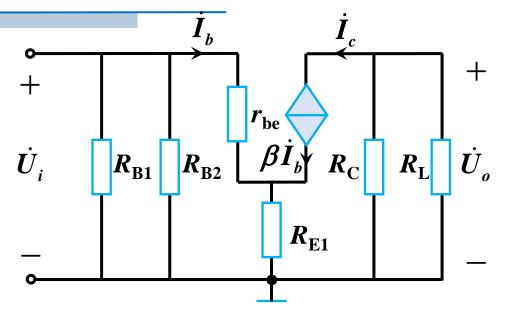
题



微变等效电路:

$$R'_{L} = \frac{R_{C}R_{L}}{R_{C} + R_{L}}$$

$$= \frac{3.3 \times 5.1}{3.3 + 5.1} = 2k\Omega$$



$$\dot{U}_i = \left[r_{be} + (1+\beta)R_{E1}\right]\dot{I}_b \qquad \dot{U}_o = -R'_L\dot{I}_c = -\beta R'_L\dot{I}_b$$

$$\dot{U}_o = -R_L'\dot{I}_c = -\beta R_L'\dot{I}_b$$

(1) 放大倍数

$$A_{u} = \frac{U_{o}}{\dot{U}_{i}} = -\frac{\beta R'_{L}}{r_{be} + (1+\beta)R_{E1}} = -\frac{80 \times 2}{1.81 + 81 \times 0.2} = -8.88$$







例 题



微变等效电路:

 r_{be} r_{be} r_{be} r_{be} r_{c} r_{c} r_{c} r_{c} r_{c} r_{c} r_{c} r_{c} r_{c}

$$\dot{U}_i = \left[r_{be} + (1+\beta)R_{E1}\right]\dot{I}_b$$

$$r'_i = \frac{U_i}{\dot{I}_k} = r_{be} + (1+\beta)R_{E1} = [1.81 + (1+80) \times 0.2] = 18.01(k\Omega)$$

$$r_i = R_{B1} / / R_{B2} / / r_i' = 8.18 \text{ k}\Omega$$

(3) 输出电阻
$$r_o = R_C = 3.3 \text{ k}\Omega$$











影响微变等效电路分析法结论的因素:

- > 在信号频率较低时,耦合电容等的影响无法忽略
- 简化的晶体管小信号模型的局限性,无法体现高频时晶体管 结电容的分流作用
- 电路分布参数的作用
- > 假设负载为纯电阻性质的片面性

上述原因,使电路放大倍数随频率的变化而变化

$$A_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{U_{o} \angle \varphi_{o}}{U_{i} \angle \varphi_{i}} = \frac{U_{o}}{U_{i}} \angle \varphi_{o} - \varphi_{i} = |A_{u}| \angle \varphi$$

A, 随频率变化曲线称为频率特性





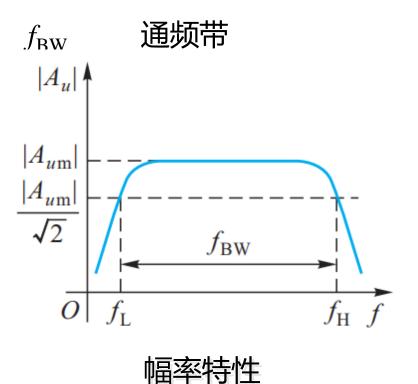




3.1.5 频率特性

 A_{μ} 幅值随频率变化

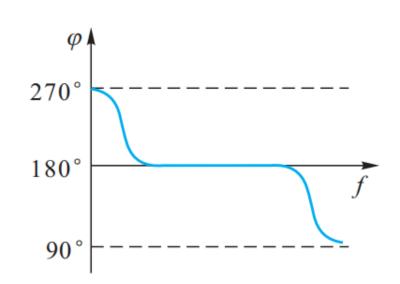
A_u相位随频率变化



 $|A_u| = F(f)$ 幅频特性

$$\varphi = F'(f)$$

相频特性



相频特性

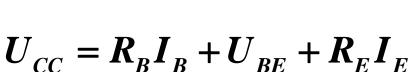








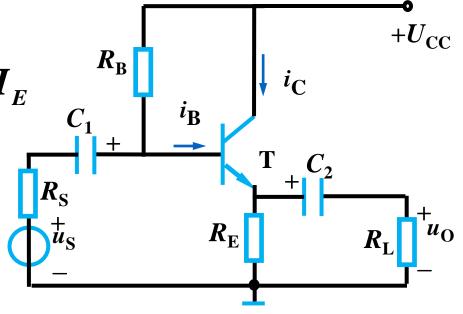
静态分析:



$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_B}$$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$$

$$I_E = (1 + \beta)I_B$$



$$\boldsymbol{U}_{CE} = \boldsymbol{U}_{CC} - \boldsymbol{R}_{E} \boldsymbol{I}_{E}$$

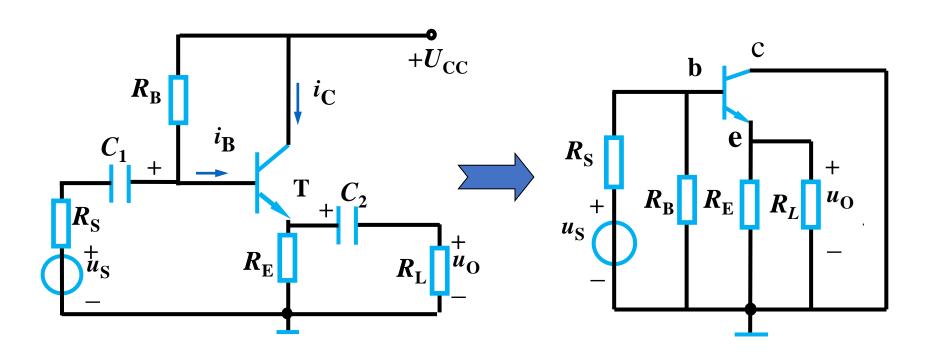








共集电极放大电路交流通路



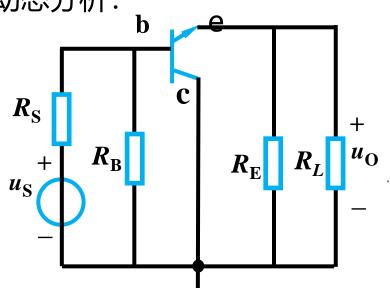


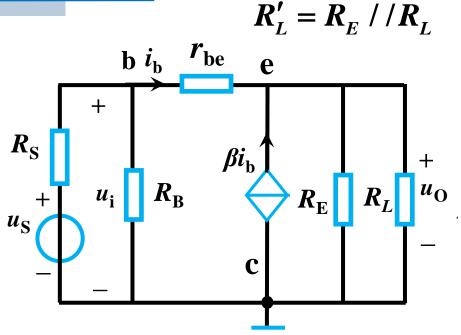












电压放大倍数 设小信号为正弦波,则电压电流可用相量表示

$$\dot{U}_{\rm i} = r_{\rm be}\dot{I}_{\rm b} + (1+\beta)R_{\rm L}'\dot{I}_{\rm b}$$

$$A_{U} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{(1+\beta)R'_{L}}{r_{be} + (1+\beta)R'_{L}}$$

$$\dot{U}_{\rm o} = (1+\beta)R_{\rm L}'\dot{I}_{\rm b}$$

(2)
$$A_U < 1$$
, $A_U \approx 1$

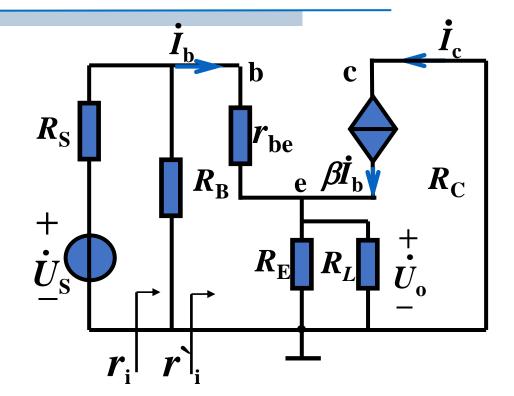








动态分析:



输入电阻

$$r'_{i} = \dot{U}_{i} / \dot{I}_{b} = r_{be} + (1 + \beta)R'_{L}$$

$$r_i = R_B / / [r_{be} + (1+\beta)R_L']$$

射极输出器<mark>输入电阻较大</mark>,说明对输入信号的衰减较少,常用于多级放大电路的输入级









输出电阻

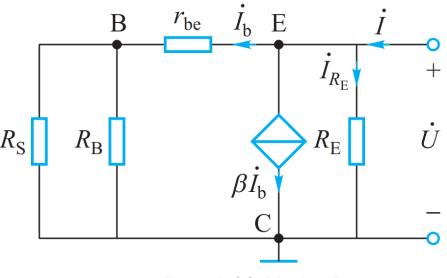
——采用外施电压法

$$\dot{I} = \dot{I}_{RE} + \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b$$

$$= \frac{\dot{U}}{R_E} + (1 + \beta) \frac{\dot{U}}{r_{be} + R'_S}$$

$$= \left(\frac{1}{R_E} + \frac{(1+\beta)}{r_{be} + R'_S}\right) \dot{U}$$

$$r_o = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{\frac{1}{R_E} + \frac{1+\beta}{r_{be} + R'_S}} = R_E / \frac{r_{be} + R'_S}{1+\beta}$$



求r。的等效电路

$$(R_S' = R_S //R_B)$$

射极输出器输出电阻较小,说明带负载能力较强,常用于小功率多级放大电路的输出级

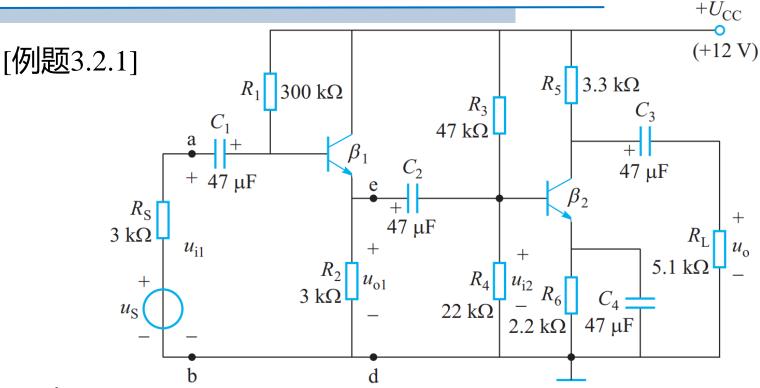






题





已知: $U_S = 20mV$, $U_{BE1} = U_{BE2} = 0.7V$, $\beta_1 = \beta_2 = 80$

求: 1) 第一级 A_{u1} 、 r_{i1} 、 r_{o1} ; 2) U_{i2}

3) 两级放大倍数 $A = \dot{U}_o / \dot{U}_{i1}$ 及输出电压 U_o ;

4) 若e, d与a, b 直接相连, U_{i2} , U_{o} 变为多少?

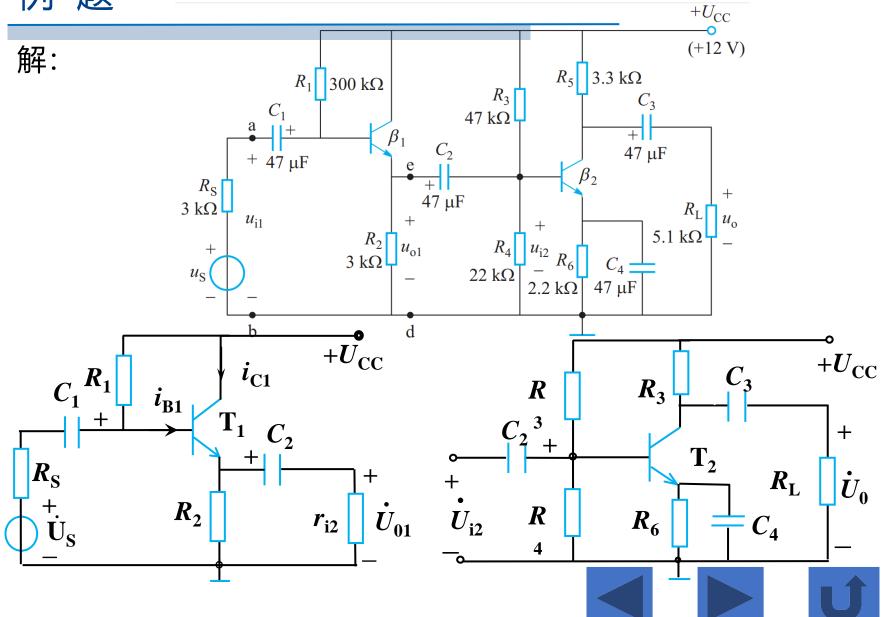










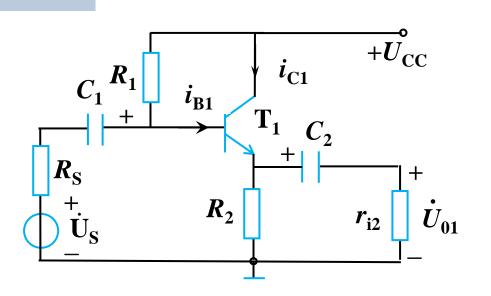


例 题



1) 第一级静态电流

$$I_{B1} = \frac{U_{CC} - U_{BE1}}{R_1 + (1 + \beta_1) R_2}$$
$$= \frac{12 - 0.7}{(300 + 81 \times 3) \times 10^3}$$
$$= 0.0208 \text{(mA)}$$



$$I_{E1} = (1 + \beta_1)$$
 $I_{B1} = 81 \times 0.0208 = 1.68 \text{(mA)}$

$$r_{be1} = 200 + (1 + \beta_1) \frac{26}{I_{E1}} = (200 + 81 \times \frac{26}{1.68}) = 1.45(k\Omega)$$

第二级的输入电阻 r_{i2} (=1.61kΩ,例3.1.2)即为第一级的负载电阻

$$R'_{L} = R_{2} / / r_{i2} = 1.05 (k\Omega)$$









电压放大倍数

$$A_{u1} = \frac{(1+\beta_1)R'_L}{r_{be1} + (1+\beta_1)R'_L} = \frac{81 \times 1.05 \times 10^3}{(1.45 + 81 \times 1.05) \times 10^3} = 0.983$$

输入电阻

$$r_{i1} = R_1 / [r_{be1} + (1 + \beta_1)R_L'] = 67.1 \text{ k}\Omega$$

输出电阻

$$r_{o1} = R_2 / / \frac{r_{be1} + R'_S}{1 + \beta_1} = 53.6 \Omega$$









2) 信号源输出电压

$$U_{i1} = \frac{r_{i1}}{R_S + r_{i1}} U_S = \frac{67.1 \times 10^3}{3 \times 10^3 + 67.1 \times 10^3} \times 20 \times 10^{-3} = 19.1 \text{(mV)}$$

第二级输入电压

$$U_{i2} = U_{o1} = |A_{u1}| \times U_{i1} = 0.983 \times 19.1 = 18.8 \text{(mV)}$$







例 题



3) 一般, n级组成的多级放大电路的放大倍数A等于各级放大电路的放大倍数之积, 即

$$A = \dot{U}_o / \dot{U}_{i1} = A_{u1} \times A_{u2} \times \cdots \times A_{un}$$

本例中,由(1)知, A_{u1} =0.983; A_{u2} =-88.4 (见[例题3.1.2])

两级放大倍数

$$A = A_{u1} \times A_{u2} = 0.983 \times (-88.4) = -86.9$$

输出电压

$$U_o = |A|U_{i1} = 86.9 \times 19.1 \times 10^{-3}V = 1.66V$$





例 题



4) 若e, d与 a, b直接相连,则 U_{i2} 就是信号源的输出电压

$$U_{i2} = \frac{r_{i2}}{R_S + r_{i2}} U_S = \frac{1.61 \times 10^3}{(3 + 1.61) \times 10^3} \times 20 \times 10^{-3} = 6.89 \text{(mV)}$$

$$U_o = |A_{u2}|U_{i2} = 88.4 \times 6.89 \text{mV} = 0.609 \text{V}$$

可见此时信号源及放大电路的输出电压比前一种情况明显减小,也就是说,信号源后面是否接入射极输出器,对信号源 的输出电压和第二级放大电路的输入输出电压均有很大的影响。

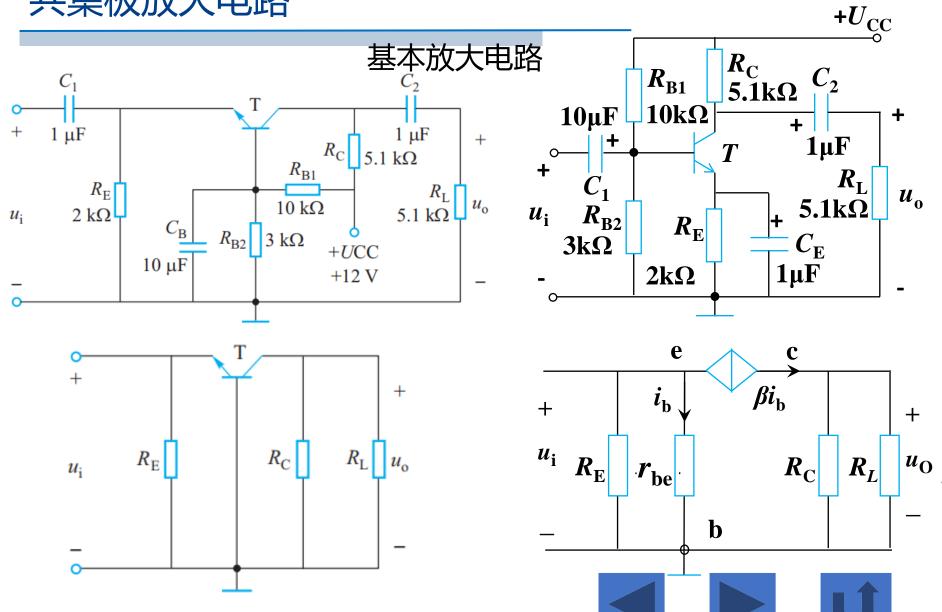








共集极放大电路



THE JIANG UNIVERSITY

3.2 共集电极放大电路

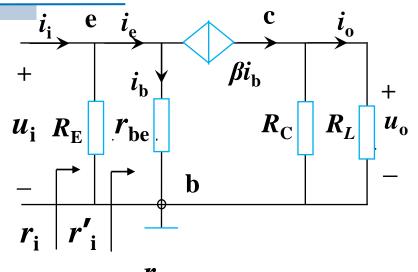
电路静态情况与[例题3.1.2]相似, 不再赘述。

电路放大倍数

$$A_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{\beta i_{b} R_{L}^{'}}{i_{b} r_{be}} = \beta \frac{R_{L}^{'}}{r_{be}}$$

输入电阻

输出电阻



$$r_{i} = R_{E} / / \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$

$$r_{o} \approx R_{C}$$

电路只能放大电压信号,不能放大电流 $(I_i > I_o)$;

输出与输入同相; r_i 小, r_o 大。

共基极放大电路的晶体管截止频率为共射级电路的 $(1+\beta)$ 倍,故具有更高的工作频率,广泛应用于高频/宽频放大电路。







3.3 共源极放大电路



3.3.1 静态分析

3.3.2 动态分析







3.3.1 静态分析

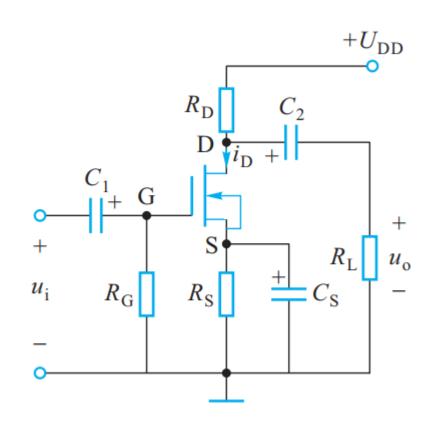


自给式偏置共源极放大电路

$$U_G = 0$$

$$\therefore \boldsymbol{U}_{GS} = -\boldsymbol{R}_{S} \boldsymbol{I}_{D}$$

仅适用于耗尽型场效应管







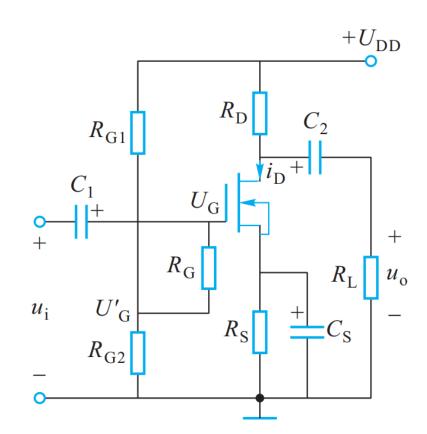




3.3.1 静态分析

分压式共源极放大电路

$$\left(I_D = I_{DO} \left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 \text{ (增强型)} \quad I_{DO} 是 U_{GS} = 2U_{GS(th)} 时的I_D \right)$$



$$I_{DO}$$
是 $U_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的 I_{D}







两方程联立求得 I_D 和 U_{GS}





电压放大倍数

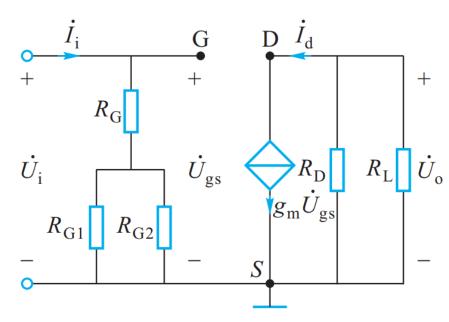
$$\dot{A}_U = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m R_L' U_{gs}}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R_L'$$

输入电阻

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_G + \frac{R_{G1}R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}$$

输出电阻

$$r_o = R_D$$



微变等效电路







例 题



[例题3.3.1] 已知电路如图, $g_m = 2mS$

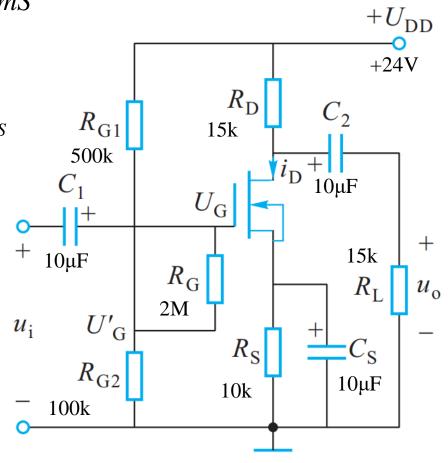
$$\coprod U_{\rm GS(\it off)} = -2V$$
 , $I_{\rm DSS} = 0.5 mA$.

求: (1) 静态工作点 I_D , U_{GS} , U_{DS}

(2) A_U , r_i , r_o

[解] (1)

$$U_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} U_{DD}$$
$$= \frac{100}{(500 + 100)} \times 24 = 4V$$











$$\begin{aligned} \boldsymbol{U}_{GS} &= \boldsymbol{U}_{G} - \boldsymbol{R}_{S} \boldsymbol{I}_{D} = 4 - 10 \boldsymbol{I}_{D} \\ \boldsymbol{I}_{D} &= \boldsymbol{I}_{DSS} \left(1 - \frac{\boldsymbol{U}_{GS}}{\boldsymbol{U}_{GS(off)}} \right)^{2} = 0.5 \times \left(1 + \frac{\boldsymbol{U}_{GS}}{2} \right)^{2} \end{aligned}$$
 联立

$$\begin{bmatrix} I_{D1} = 0.863 \text{mA} \\ U_{GS1} = -4.63 \text{V} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} I_{D2} = 0.417 \text{mA} \\ U_{GS2} = -0.17 \text{V} \end{bmatrix}$$
 ②

根据题意第①组解不符,因此静态工作点为解②

$$U_{DS} = U_{DD} - (R_D + R_S)I_D$$
$$= 24 - (15 + 10) \times 0.417 = 13.6 \text{ V}$$







例 题



(2) 电压放大倍数

$$A_U = -g_m R_L' = -15$$

输入电阻

$$r_i = R_G + \frac{R_{G1}R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 2.08 \text{M}\Omega$$

输出电阻

$$r_o = R_D = 15 \text{k}\Omega$$









3.4 分立元件组成的基本门电路

3.4.1 二极管与门电路

3.4.2 二极管或门电路

3.4.3 晶体管及场效晶体管非门电路







基本门电路概述



门电路是一种开关电路,其输入和输出之间存在一定的因果 关系即逻辑关系。

在逻辑电路中,输入输出信号通常用高低电平来描述,用0和 1来表示两种对立的逻辑状态。

正逻辑: 1表示高电平, 0表示低电平;

负逻辑: 0表示高电平, 1表示低电平。

基本的逻辑关系有:与逻辑、或逻辑、非逻辑;

相对应的基本门电路有:与门、或门、非门。



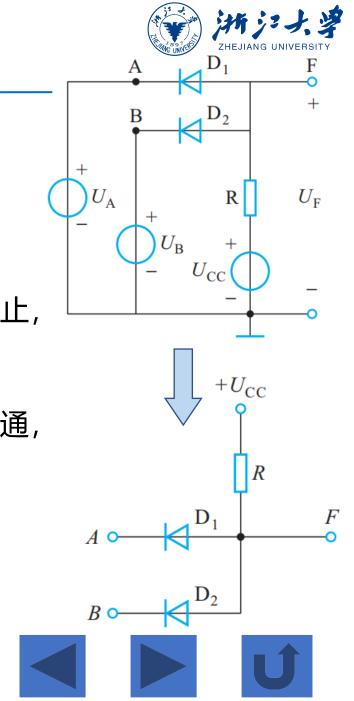




3.4.1 二极管与门电路

工作原理:

- (1) 当 $U_A=U_B=0V$ 时, D_1 、 D_2 均导通, 故 $U_F=0V$,即 F 为低电平0;
- (2) 当 U_A =0V, U_B =3V时, D_1 导通, D_2 截止, 故 U_F =0V, 即 F 为低电平0;
- (3) 当 U_A =3V, U_B =0V时, D_1 截止, D_2 导通, 故 U_F =0V, 即 F 为低电平0;
- (4) 当 $U_A=U_B=3V$ 时, D_1 、 D_2 均导通, 故 $U_F=3V$,即 F 为高电平1。



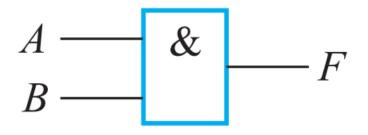


3.4.1 二极管与门电路

二输入与门逻辑表

输入		输出
A	В	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

二输入与门逻辑符号



函数表达式:

$$F = A \cdot B$$







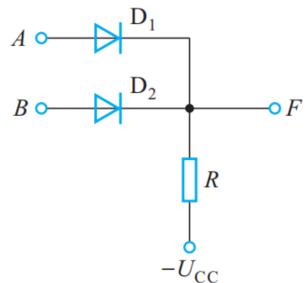


3.4.2 二极管或门电路

工作原理:

(1) 当 $U_A=U_B=0V$ 时, D_1 、 D_2 均导通,故 $U_F=0V$,即F为低电平0;

(2) 当 U_A 、 U_B 不全为0时, D_1 、 D_2 至 少有一个导通。如 U_A =3V 时, D_1 导通,此时 U_F = U_A =3V,即F为高电平1。











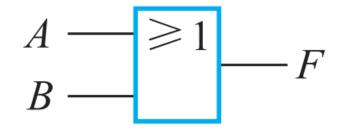


3.4.2 二极管或门电路

二输入或门逻辑表

输入		输出
A	В	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

二输入或门逻辑符号



函数表达式:

$$F = A + B$$







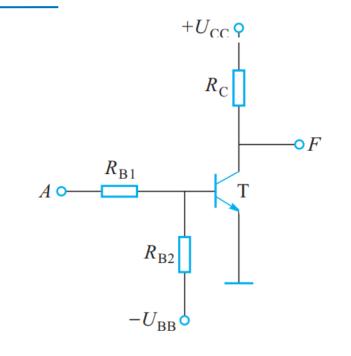


3.4.3 晶体管及场效晶体管非门电路

1. 晶体管非门电路

输入 U_A 为低电平0时, $U_{BE}<0$,晶体管发射结反偏,管子截止,输出端F为高电平1;

輸入 U_A 为高电平时,管子饱和, 输出端 F 为低电平0。



要使得管子饱和,须满足

$$I_{CS} = \frac{U_{CC} - U_{CES}}{R_C} \approx \frac{U_{CC}}{R_C}$$

此时基极电流至少为

$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta}$$
 ——临界饱和基极电流

保证晶体管饱和的条件 $I_B \ge I_{BS}$









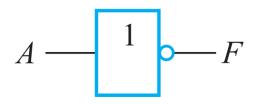
3.4.3 晶体管及场效晶体管非门电路

非门逻辑表、逻辑符号及函数表达式

非门逻辑表

输入	输出
A	F
0	1
1	0

非门逻辑符号



函数表达式:

$$F = \overline{A}$$







例 题



[例3.4.1]

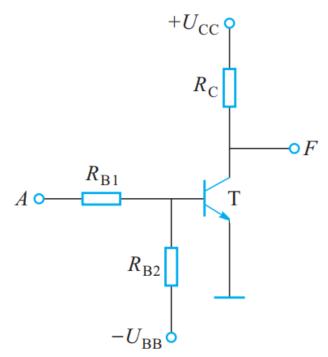
已知: $R_{B1} = 2.7k\Omega$, $R_{B2} = 10k\Omega$, $R_{C} = 1k\Omega$, $U_{CC} = 5V$, $-U_{BB} = -5V$, $\beta = 30$, $U_{BES} = 0.7V$, $U_{CES} \approx 0V$, 截止时 $I_{C} \approx 0$, $U_{IL} = 0V$, $U_{IH} = 3V$; 试分析管子的输出状态。

解: (1) 输入 U_A 为低电平0时

$$U_{BE} = -\frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{BB}$$

$$= -\frac{2.7 \times 10^{3}}{(2.7 + 10) \times 10^{3}} \times 5 = -1.06(V)$$

此时晶体管可靠截止, $U_F \approx U_C = 5V$, 输出F为高电平。









THE JIANG UNIVERSITY

例 题

(2) 输入 $U_A = 3V$, A 为高电平1时

将晶体管基极左侧作戴维南等效 开路电压

$$U_{BO} = U_{IH} - \frac{U_{IH} + U_{BB}}{R_{B1} + R_{B2}} R_{B1}$$

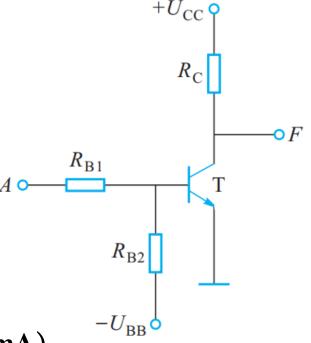
$$= \left[3 - \frac{3+5}{(2.7+10)\times10^3} \times 2.7\times10^3\right] = 1.3(V)$$

等效电阻
$$R_B = R_{B1} / / R_{B2} = 2.13 \text{k}\Omega$$

基极电流
$$I_B = \frac{U_{BO} - U_{BES}}{R_B} = \frac{1.3 - 0.7}{2.13 \times 10^3} = 0.28 \text{(mA)}$$

临界基极饱和电流
$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} = \frac{U_{CC}}{\beta R_C} = \frac{5}{30 \times 1 \times 10^3} = 0.17 \text{(mA)}$$

因 $I_B > I_{BS}$, 晶体管处于饱和 , $U_F = U_{CES} \approx 0V$, F 为0。









3.4.3 晶体管及场效晶体管非门电路

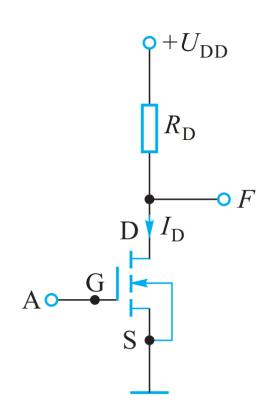
2. 场效晶体管非门电路

NMOS非门电路

工作原理:

- (1) 当输入 U_A 为低电平0时,使 $U_{GS} < U_{GS(th)}$,管子处于截止状态, $I_D = 0$, $U_F = U_{DD}$;输出端 F为高电平1;
- (2) 当输入 U_A 为高电平1时, $U_{GS} > U_{GS(th)}$, 管子饱和导通, $U_F \approx 0$, 输出端 F 为低电平0。

故电路满足非逻辑关系。









ZHEJIANG UNIVERSITY

3.4.3 晶体管及场效晶体管非门电路

互补型MOS非门电路

 T_N : 增强型NMOS管, 驱动管; T_P : 增强型PMOS管, T_N 的负载管。

设 T_N 和 T_P 的开启电压为 $U_{GSN(th)}$ 和 $U_{GSP(th)}$

(1) A=0 (设 $u_A = 0V$), $U_{GSN} = 0 < U_{GSN(th)}$, T_N 截止,而 $|U_{GSP}| \approx |U_{DD}| > |U_{GSP(th)}|$, T_P 导通, $u_F \approx U_{DD}$,F=1,为高电平。

 $(2) \textbf{A=1} \quad (设 \ u_{A} = U_{DD} \) \quad , U_{GSN} = U_{DD} > U_{GSN(th)} \ , \quad T_{N}$ 导通,而 $U_{GSP} \approx 0 V < \left| U_{GSP(th)} \right| \ , \quad T_{P}$ 截止, $u_{F} \approx 0 V \ , \quad \textbf{F=0} \ , \quad$ 为低电平。

从以上分析可知,该电路具有非门的功能。

相比于NMOS非门电路,互补型MOS在工作时只有一个MOS管导通,静态功耗很小;另外因 T_N , T_P 导通电阻小,负载电容充电或放电很快,故工作速度更快。











本章结束 返回目录 第4章 数字集成电路

